Данни на транзистора

2T3511 – NPN силициев планарно-епитаксиален маломощен транзистор – BG
корпус C65 (TO-92)

маса max – 0,4 g

група Б

- U_{CB} max = 20 V
- U_{EB} max = 5 V
- U_{CE} max = 18 V
- Ic max = 100 mA
- Pc max = 200 mW
- f_T = 120 MHz (min) $-U_{CE}$ = 10 V; Ic = 10 mA; f = 100 MHz
- C_{TC} = 6 pF (max) $-U_{CE}$ = 10 V; I_E = 0 mA; f = 1 MHz
- h11e = 4 kΩ
- h12e = $1{,}1.10^{-4}$
- h21e = β = 20 (min) ÷ 200 (max) $-U_{CE}$ = 10 V; I_E = 1 mA; f = 1 kHz
- h22e = 14 μS
- $U_{(BR)CEO}$ = 18 V; I_E = 100 μA; Ic = 0 μA
- I_{CBO} = 50 μA – U_{CB} = 10 V; I_E = 0 μA
- I_{CBO} = 50 μA – U_{CB} = 20 V; I_E = 0 μA
- I_{EBO} = 1 μA
- I_{EBO} = 20 μA $-U_{EB}$ = 1 V; Ic = 0 μA
- I_{EBO} = 10 μA $-U_{EB}$ = 5 V; Ic = 0 μA
- tj max = 125 °C
- tstg = –25 °C ÷ +100 °C
- цокъл 7